技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位信息** | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 南充明德之星科技有限公司 | 社会统一信用代码 | 91511304MA629C9D5Q |
| 联系人 | | | | 庹旭 | 联系电话 | 15983777328 |
| 行政区域 | | | | 四川省（自治区、直辖市）南充市（地）市嘉陵（县） | | |
| 是否在国家高新区内？ | | | | □是 （高新区名称）  ☑否 | | |
| 所属行业 | | | | 新型显示 | 技术领域 | 新光源显示 |
| 上一年度  营业总收入 | | | | 193（万元） | 人员总数 | 12 （人） |
| 高新技术企业认定 | | | | □是☑否 | 科技型中小企业备案 | ☑是□否 |
| 需求名称 | | 大功率GaN基蓝光激光器及模组研发 | | | | |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ☑技术研发（关键、核心技术）  □产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | |
| 需求  内容 | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）   1. 产品激发波长范围在450nm~460nm之间； 2. 激光器单片最大输出功率250mW; 3. 激光模组输出功率5W；   需要明确的散热解决方案，因为GaN晶体管比传统硅晶体管功率密度更高，可承受的工作温度更高(～500℃)，但与所有半导体器件一样，GaN晶体管工作时也会产生多余热量，从而影响其电性能。在传统衬底上外延GaN存在晶格不匹配的困难，导致器件厚度达到几十、甚至几百微米。这非常不利于芯片散热。 | | | | |
| 现有  基础 | （已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）  激发波长450nm~460nm；  激光器单片最大输出功率180mW;  激光模组输出功率4W； | | | | |
| 产学研合作要求 | 简要  描述 | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）  高校或中科院的半导体激光器研发团队 | | | | |
| 合作  方式 | □技术转让 □技术入股 ☑联合开发 □委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 ☑知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | | ☑是 □否  □部分公开（说明） | | | |
| 同意接受  专家服务 | | | ☑是  □否 | | | |
| 同意参与解决方案筛选评价 | | | ☑是  □否 | | | |
| 同意出资奖励优秀解决方案 | | | □是，金额万元。（奖金仅用作鼓励挑战者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  ☑否  法人代表： 年 月 日 | | | |